SEMICONDUCTOR

TECHNICAL DATA

東芝トランジスタ TOSHIBA TRANSISTOR

2SC2461A

SILICON NPN EPITAXIAL TYPE (PCT PROCESS)※

TENTATIVE

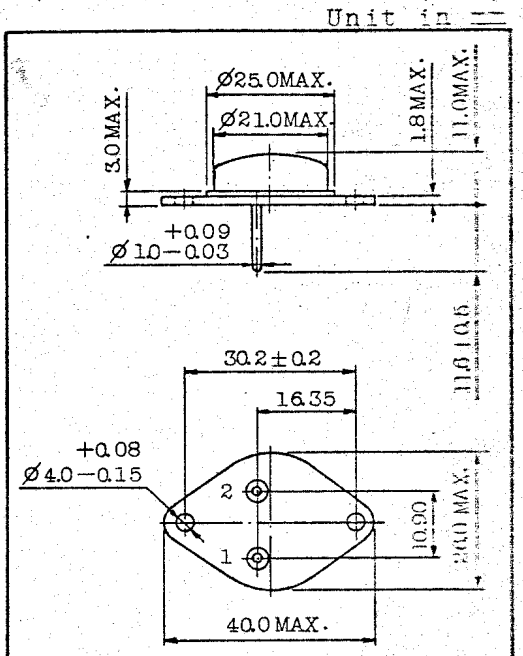
○ 電力増幅用

○ Power Amplifier Applications.

- 高耐圧です。V_{CEO} = 160V (MIN.)
- トランジション周波数が高い。f_T = 80MHz (TYP.)
- 2SA1051Aとコンプリメンタリになります。
- 100W Hi-Fi オーディオ・アンプに最適です。

- Complementary to 2SA1051A.
- Recommended for 100W High-Fiderity Audio Frequency Amplifier Output Stage.

Unit in mm



1. BASE
2. EMITTER
COLLECTOR (CASE)

JEDEC	TO-3
EIAJ	TC-3, TB-3
TOSHIBA	2-21A1A

最大定格 MAXIMUM RATINGS (Ta = 25℃)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	160	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	160	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	5	V
コレクタ電流	I_C	15	A
エミッタ電流	I_E	−15	A
コレクタ損失 (Tc=25℃)	P_C	150	W
接合温度	T_j	150	℃
保存温度	T_{stg}	−65～150	℃

アクセサリはAC73を適用

MOUNTING KIT NO. AC73

※ PCT技術により製造されています。

Produced by Perfect Crystal Device Technology.

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25℃)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	V_{CB}=160V, I_E=0	—	—	10	μA
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	V_{EB}=5V, I_C=0	—	—	50	μA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	I_C=0.1A, I_B=0	160	—	—	V
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	I_E=0.01A, I_C=0	5	—	—	V
直流電流増幅率	$h_{FE(1)}$	V_{CE}=5V, I_C=1A	55	—	240	—
	$h_{FE(2)}$	V_{CE}=5V, I_C=5A	40	—	—	—
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	I_C=5A, I_B=0.5A	—	—	2.0	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	V_{CE}=5V, I_C=5A	—	—	2.0	V
トランジション周波数	f_T	V_{CE}=10V, I_C=1A	—	80	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	V_{CB}=10V, I_E=0 f=1MHz	—	200	—	pF

Note $h_{FE(1)}$により下表のように分類し，現品表示してあります。

According to the value of h_{FE} · the 2SC2461A is classified as follows.

CLASSIFICATION	MIN.	MAX.
2SC2461A-R	55	110
2SC2461A-O	80	160
2SC2461A-Y	120	240